

P-i-n фотодиод на основе кремния ФД342

Фотодиод предназначен для применения в качестве высокочувствительного быстродействующего приемника инфракрасного излучения в составе опико-электронной аппаратуры различного назначения.

Фотодиод состоит из пластины высокоомного кремния с p-i-n структурой расположенной в металлическом корпусе с металлостеклянными выводами и плоским входным окном

Технические характеристики:



Количество фоточувствительных элементов (ФЧЭ)	1
Диаметр ФЧЭ, мм	14
Диапазон спектральной чувствительности, мкм	0,4 – 1,1
Токовая монохроматическая чувствительность на длине волны 1,06 мкм, А/Вт, не менее	0,2
Токовая монохроматическая чувствительность в масимуме, А/Вт, не менее	
Темновой ток, мкА, не более	7
Рабочее напряжение, В	75
Граничная частота, МГц, не менее	5